

ПРОТОКОЛ № 10/2018
Заседания Конкурсной Комиссии
на замещение вакантных должностей научных работников
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института сверхвысококачественной полупроводниковой электроники
Российской академии наук

г. Москва

13 апреля 2018 г.

Присутствовали:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Председатель комиссии | - доктор технических наук, профессор, директор ИСВЧПЭ РАН С.А.Гамкрелидзе |
| Заместитель председателя комиссии | - кандидат физико-математических наук, заместитель директора по научной работе ИСВЧПЭ РАН Д.С. Пономарев |
| Секретарь комиссии | - кандидат физико-математических наук, ученый секретарь ИСВЧПЭ РАН Р.А. Хабибуллин |
| Члены комиссии: | - кандидат технических наук, председатель Профкома ИСВЧПЭ РАН А.Ю. Павлов |
| | - доктор технических наук, профессор, зам. ген. директора по научной работе ОАО «НПП «Пульсар» Ю.В. Колковский |
| | - член-корреспондент РАН, врио директора ФТИАН В.Ф. Лукичев |
| | - доктор технических наук, профессор, зам. директора НИИВТ им С.А. Векшинского С.Б. Нестеров |

Всего: 7 человек из 7 членов Конкурсной комиссии.

Повестка дня:

Проведение конкурса на замещение вакантной должности старшего научного сотрудника лаборатории № 104 «Лаборатория исследований принципов моделирования и проектирования наногетероструктурных СВЧ-транзисторов и МИС, и исследования их характеристик в см- и мм- диапазонах»

Слушали:

Председатель Конкурсной комиссии ИСВЧПЭ РАН д.т.н., проф. С.А.Гамкрелидзе проинформировал участников заседания о том, в Конкурсную комиссию ИСВЧПЭ РАН поступило заявление и комплект документов, необходимых для проведения конкурса от Крапухина Дмитрия Владимировича для избрания его на должность старшего научного сотрудника лаборатории «Лаборатория исследований принципов моделирования и проектирования наногетероструктурных СВЧ-транзисторов и МИС, и исследования их характеристик в см- и мм- диапазонах». Директор зачитал характеристику Крапухина Д.В., подписанную заведующим лабораторией №104 Гнатюком Д.Л. В ней, в частности отмечается, что в 2016 году Дмитрий Владимирович окончил аспирантуру Московского Технологического Университета (МИРЭА) по специальности 05.27.01

«Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нано-электроника, приборы на квантовых эффектах».

В процессе работы в ИСВЧПЭ РАН Крапухин Д.В. выполнял различные исследовательские задачи как экспериментального, так и теоретического характера: проводил измерения пассивных элементов, транзисторов и МИС, проводил моделирование МИС, занимался созданием моделей транзисторов и подготовкой комплекта фотошаблонов. Крапухин Д.В. широко участвовал в подготовке и выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и грантов ИСВЧПЭ РАН, в том числе путем проведения сбора, анализа и обобщения данных из научной литературы, проектирования и моделирования МИС, проведения экспериментальных исследований и обработки их результатов, подготовки отчетной документации. Крапухин Д.В. участвовал в выполнении ряда научно-исследовательских работ. По одной опытно-конструкторской работе ИСВЧПЭ РАН, выступал ответственным исполнителем. В ходе трудовой деятельности им была подготовлена и представлена к защите 20 декабря 2016 года диссертационная работа на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.27.01.

Крапухин является соавтором более 10 статей в ведущих отечественных и зарубежных научных журналах, одного свидетельства на топологию интегральной микросхемы, принимал участие в написании монографии. Результаты исследований неоднократно представлялись лично Крапухиным Д.В. на отечественных и международных научных конференциях. В процессе работы в ИСВЧПЭ РАН он проявил себя квалифицированным специалистом в области проектирования и моделирования МИС, способным к самостоятельной научно-исследовательской работе.

Документы удовлетворяют квалификационным характеристикам. Больше заявок на занятие этой должности в Конкурсную комиссию не поступало.

Постановили:

По 1-му пункту повестки дня:

1) Согласно п. 11 Приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 № 937 в продлении срока рассмотрения заявок для проведения собеседования с претендентом необходимости нет.

2) Признать конкурс на замещение вакантной должности старшего научного сотрудника лаборатории № 104 «Лаборатория исследований принципов моделирования и проектирования наногетероструктурных СВЧ- транзисторов и МИС, и исследования их характеристик в см- и мм- диапазонах» состоявшимся в объявленные сроки.

3) Согласно п. 12 Приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 № 937 по итогам рассмотрения заявки Конкурсная комиссия составила рейтинг претендента на основании бальной оценки, выставленной членами Конкурсной комиссии претенденту, исходя из сведений, содержащихся в заявке и иных прикрепленных к заявке материалах, которые наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и результативность претендента, Конкурсная комиссия приняла решение избрать на должность:

- старшего научного сотрудника лаборатории исследований принципов моделирования и проектирования наногетероструктурных СВЧ- транзисторов и МИС, и исследования их характеристик в см- и мм- диапазонах» – Крапухина Дмитрия Владимировича.

Председатель Конкурсной комиссии
д.т.н., профессор

Секретарь Конкурсной комиссии
к.ф.-м.н.

«13» апреля 2018 г.




С.А. Гамкрелидзе


Р.А. Хабибуллин